

**ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ**



ПЕРЕЛІК

Комплектувальних виробів третіх країн (в першу чергу - країни НАТО та ЄС), виявлених під час дослідження зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, їх вузлів, агрегатів та елементів, що використовує російська федерація при їх створенні, в ході бойових дій
(Книга 4)

Київ – 2024

Перелік комплектувальних виробів третіх країн (в першу чергу- країн НАТО та ЄС), виявлених під час дослідження зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, їх вузлів, агрегатів та елементів, що використовує російська федерація при їх створенні, в ході бойових дій.
(за II квартал 2023 року)

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
1.	Пульт оператора РЛС ІЛНІМ-1 "Фара-ВР" / РЛС ІЛ277 "Соболятник"  Пульт оператора ФВР.06.1 ТЕЦА.469536.106 № E016				Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
1.1.	Плата ТЕЦА.467444.071 ЗАВ №E025 	Мікросхема XILINX Virtex-II PRO XC2VP20 FFG896CGB1335 D3047590A 	США (XILINX)		

№ п/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) знищення зразку ОБТ	Примітка
	 Зворотній бік плати (пункт № 1 табл.) ТЕЦА.4674444.072 ЗАВ. № E013	Мікросхема RM7000C-600T 0304 G61448,1LK, B001 	Південна Корея (PMC-Sierra)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Мікросхема SM722GF8-AB 1339, R1W99, P03N9,18 F6DT 	Тайвань (Silicon motion)		
		Мікросхема W83627HF-AW 22363G235857802SB 	Тайвань (Windbond)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Оперативна пам'ять 256m 2Rx16 PC133 SDRAM SO A53165-0341 RoHS 	Тайвань (Transcend)		Досліджено ЦНД ОБТ ЗСУ
		Мікросхема K4S561632j-uc7 S5616 WRJ225GAN 	Південна Корея (Samsung)		
		Модульний перетворювач YM05S05-G B14132Z0380 	США (Bel Power Solution)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/інциденту зразку ОБТ	Примітка
		Таймер для материнських плат W83194R-67B 	Тайвань (Windbond)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Регулятор напруги CS4281-CQ EP ATARBD0105 	США (Crystal Semiconductor)		
		Мікросхема аудіо-кодеку 4297A-JQ YF7AHXCQ0403 	КНР (Crystal Semiconductor)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема USB-контролеру ISP156BM 8W9011384, 15 TSD1231E 	ST Microelectronics (Швейцарія)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
1,2.	 Друкована плата TEЦА.469535.321-01 Зав. № E012 (TEЦА.687254.134 V.03)	Мікросхема мережевого перетворення сигналів Pulse HX5008NL 1409-PP  Мікросхема SG9SCDD8GHYCB1 PMF1251402 	КНР (Pulse Electronix) США – материнська компанія; Малайзія – виробничі потужності (SMART Modular Technologies, Inc.)		

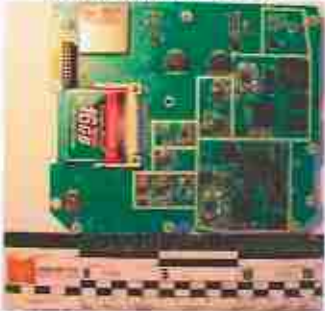
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Високошвидкісна, енергоефективна мікросхема XCR3128XL V010CMN1441 F5029026A 	США (XILINX)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Мікросхема ошифрування та декодування відео та звуку SAA7134HL CM4038 07 TSD10301 	Нідерланди (NXP Semiconductors)		
		Мікросхема ADM211 EA#207 2301115.1 	США (Analog Devices)		

№ зп	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (пайменування компанії виробника)	Відомості про обсталини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
1.3.	 TFT дисплей NL10276BC13-01C B4922013 A21A473003036	Блок дисплея 	Японія (NLT Technologies)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
2.	Апаратна машина автоматизованого мобільного комплексу "Торн - МДМ"  	Радіоприйомник ICOM IC-R8500  Високостабільний кварцовий генератор CR-293 	Японія (ICOM) Японія (ICOM)	17 березня 2022 року в Миколаївській області Силами оборони України захоплено російський автоматизований мобільний комплекс "Торн - МДМ" в пошкодженому стані	Досліджено в/ч А4629

№ з/п	Найменування та тип ОІЗСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна-виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОВТ	Примітка
		Синтезатор голосу Icom UT-102 	Японія (ICOM)		Досліджено в/ч А4629
		Кварцовий фільтр FL-52A 	Японія (ICOM)		
3.	Радіостанція Р-168-25У-2 	Синтезатор частоти в системі АПЧ PE3291 	США (Peregrine Semiconductor Corp.)	Трофейний зразок ОВТ був захоплений добровольчим батальйоном "Скеля" в місті Барвінкове, Харківської обл. 17 вересня 2022 року	

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, одиниці вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Електромагнітне реле B4CB4.5Z 	Японія (FUJITSU)		Досліджено в ч. А4629
		Низькопотужний операційний підсилювач з однополярним живленням AD822 	США (Analog Devices)		
		DC-DC інтегральний перетворювач ICL7662 	США (Maxim Integrated)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		44-контактний вдосконалений 8-розрядний CMOS PIC16F887 	США (Microchip Technology Inc.)		Досліджено в/ч А4629
		Низьковольтний 16-розрядний розширювач вводу/виводу PCA9555 	Нідерланди (NXP Semiconductors)		
		Частотний змішувач ВЧ ADE-12 	США (Analog Devices)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/звичайний зразок ОБТ	Примітка
4.	Тактичний термінал ТТ-6,5  Заводський номер: 290287. Розробник і виробник зразка: АО "Концерн "Созвездие", м. Воронеж, РФ.				Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
4.1.	Друкована плата ИТНЯ.687263.197  Новосибірська електронна компанія	Трансформатор Pulse HX1188 NL 1848-C CHINA (трансформатор сигнальний: LAN; SMD: -40+850°C; -1дБ; мережа: ethernet 10/100 Мб/с) 	США Країна походження: CHINA (країна в якій виконувався виробничий процес) (Pulse Electronics Corporation)		

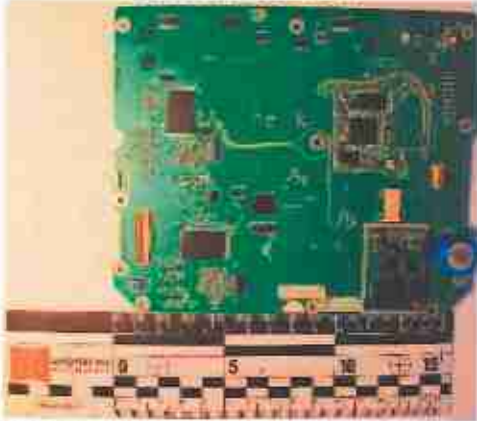
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітки
		MAXIM MAX3245E ETX 909 BJAL TAQ Комунікаційний інтерфейс із живленням 3В, функціями автоматичного вимкнення/пробудження можливостями високої швидкості передачі даних, струм живлення 1мкА 	США (Maxim Integrated)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Davicom DM9000BIEP 1849NS DFJMY.1T5 Інтегрований однокристальний контролер Fast Ethernet MAC, підтримує 8,16,32-розрядні інтерфейси для доступу до внутрішньої пам'яті 	Тайвань (Davicom)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування комерційної виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		HPS 12F JL D8K П'єзовипромінювач SMD Напруга 3В, струм 3мА, частота 4 кГц 	Гонконг, Китай (JL World Corporation Limited)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		2C128 F44209-1805 PHILIPPINES C6-BMS Програмована логічна інтегральна схема, Тип пам'яті CMOS, кількість мікрокомірок 128, затримка 7,5 нс, Напруга живлення 1.8В 	США (XILINX)		
		151CBU6D STM32L GQ28Z1EV6 CHN GQ 903 Інтегральна мікросхема Розмір ядра 32-розрядний, напруга живлення 1,7-3,6В, швидкість 80 МГц 	Швейцарія (STMicroelectronics)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		XILINX SPARTAN XC3S700A FTG256AGQ1905 D5810863A 5C/4I Інтегральна схема FPGA(програмована вентильна матриця) Частота 250МГц, напруга живлення 1,26В, розмір оперативної пам'яті 45Кб 	США (XILINX)		Досліджено ЦНД ОБТ ЗСУ
		79A6RRJ VD244B 16-ти розрядний буфер та лінійний драйвер для роботи при низькій напрузі 3,3В 	США (Texas Instruments)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/звичесний зразку ОБТ	Примітка
		XCF045 60813 11N VS Внутрішньосистемна програмована конфігурація платформи Flash Ємність зберігання 4 Мб Напруга живлення 3 – 3.6В 	США (XILINX)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		SAMSUNG S5PC100X66-YA40 A1413 ARM N71UGA Процесор 1-ядерний, максимальна частота 833МГц, розрядність 32біт, тип ядер ARM Cortex-A8, Технологія процесора ARMv7 	Південна Корея (SAMSUNG)		

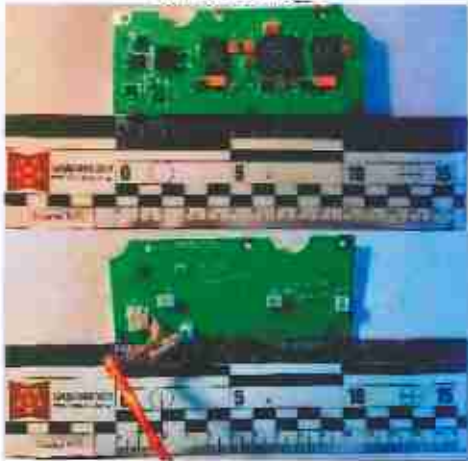
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, штепселя (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення вразку ОБТ	Примітка
		SPANSION AL016J70BFI02 847BB845 M Флеш пам'ять Напруга живлення від 2,7 до 3,6 В, розмір пам'яті 16 Мб, тип пам'яті NOR, швидкість 70 нс, ширина шини даних 8біт/16 біт. 	США (Spansion) Тайвань (Transcend)		Досліджено ЦНД ОБТ ЗСУ

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
4.2.	Друкована плата ИТНЯ.687263.197  Новосибірська електронна компанія	NEC/TOKIN FG 5,5V 1.0F Суперконденсатори серії FG призначені для зберігання високої енергії. Ємність 1.0 Ф, Номінальна напруга 5,5В, Опір 350м 	Японія (NEC TOKIN Corporation)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		TMS320 VC5509AGHN 4A-72АНК2W Високопродуктивний малопотужний цифровий процесор сигналів Тактова частота 108,144,200 МГц, 192 Кб оперативної пам'яті з єдиним доступом (SARAM), 64Кб на мікросхемі з одним станом очікування, 16-бітна зовнішня паралельна шина пам'яті 	США (Texas Instruments)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/винищення зразку ОБТ	Примітка
		MAXIM MAX3227E EAE 1726 Серія RS-232 інтерфейсів MAX3227E Максимальна швидкість передачі даних 1 Мбит/с, напруга живлення 3,3 – 5В, номінальний струм живлення 1мкА. 	США (Maxim integrated)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Honeywell HMC6343 інтегрований модуль компаса, який включає мікропрограмне забезпечення для обчислення курсу та калібрування магнітних спотворень. Триосьові МР-датчики, акселерометри і мікропроцесор в одному, Напруга живлення 2,7-3,6В 	США (Honeywell)		

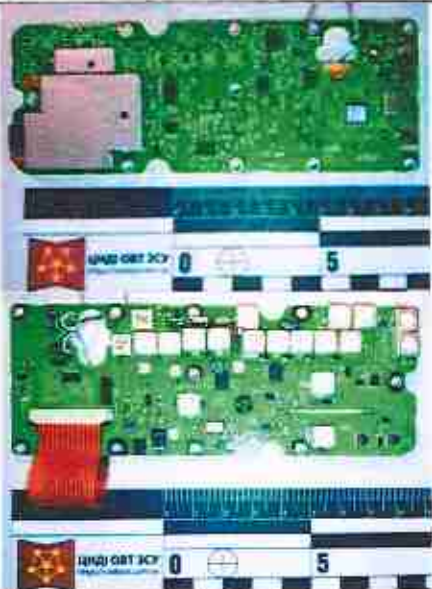
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, одиниць вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Ціпередньо визначені країни виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		SAMSUNG 248 K9K8G08U0A Флеш-пам'ять NAND 1G x 8 Bit / 2G x 8 Bit Напруга живлення - 2,70 В ~ 3,60 В Організація - Масив комірок пам'яті: (1G + 32M) x 8 біт - Регістр даних: (2K + 64) x 8 біт 	Південна Корея (SAMSUNG)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		SPANSION FL128SAIF00 849QQ076 A Інтегральна Схема 	США (Spansion)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплексувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Atheros AR9331-AL1F PPU592.003B 1604 Високоінтегрована система на чіпі (SoC) IEEE 802.11 2.4ГГц для точок доступу та маршрутизаторів бездротової мережі 	США (Qualcomm Atheros)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		TX14D17VM1BAB 5,7-дюймовий VGA дисплей Колір Розташування пікселів R, G, B Вертикальна смуга, РК-дисплей типу Transmissive Color TFT, 	Японія (Hitachi)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис пульта, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення тразку ОБТ	Примітка
4.3.	Друкована плата 687254.648_1  Новосибірська електронна компанія	PSMN035 150B PEM1749A7 3388 FET транзистор Опір відкритого каналу 35мОм Напруга сток-витік 150В Номинальний струм стоку 50А 	Нідерланди (NXP Semiconductors)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		LTM8061V-84 N08910 1915MY Автономний літій-іонний зарядний пристрій Діапазон входної напруги 1-елемент від 4,95 до 32В 2-елемент від 8,2 до 8,4В Програмований зарядний струм до 2А 	США (Linear Technology)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) зняття зразку ОБТ	Примітка
		Танталовий SMD конденсатор R+ 226 25 601 Ємність 22мкФ Робоча напруга 25В Робоча температура -55 – 125°C 	США (KEMET Electronics)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		LINEAR LTM8027V N58911 1821MY DC-DC інтегральний перетворювач Вхідна напруга 4.5 - 60В Вихідна напруга 2.5 - 24В Частота перетворювання 100-500 кГц 	США (Linear Technology)		

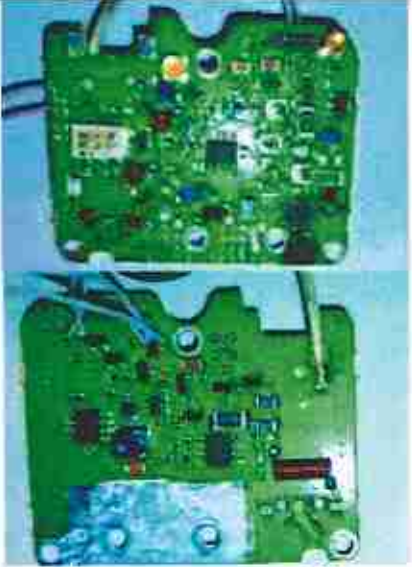
№ з/п	Найменування та тип ОВСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/типлення зразку ОВТ	Примітка
		4463B AB W85K Транзистор польовий P-MOSFET, опір у відкритому стані 11мОм, напруга затвор-витік =12В, розсіювана потужність 0,95Вт 	США (Vishay Intertechjlogy)		Досліджено ЦНДІ ОВТ ЗСУ
5.	Радіостанція Р-168-0,5УМ  Шифр: "Акведук-0,5УМ". Серійний номер: 324808. виробник: "АО "Концерн "Созвездие", рф. Виробник зразка: "АО "Рязанский радиозавод".				

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/підпекання тижку ОБТ	Примітка
5.1	 Електронна плата №1 з двох сторін	Мікросхема #625 8403 A10 (4-канальний цифровий потенціометр) 	США (Analog Devices)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Мікросхема EM75RF LMX2306 TMD (Синтезатор частоти низької потужності) 	США (National Semiconductors)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема 488E X2470 SLE (LMX2470 2.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 800 MHz Integer-N PLL) ФАПЧ дробового N з допоміжним цілим N PLL/ LMX2470 має типове споживання струму 4,1 мА при 2,5 В. Застосовується у стільникових телефонах та базових станціях CDMA, WCDMA, GSM/GPRS, TDMA, EDGE, PDC. 	США (National Semiconductors)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Мікросхема NXP SA636D* 0943003 Yn6438B (Низьковольтний змішувач FM IF із високошвидкісним RSSI) 	Нідерланди (NXP Semiconductors)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/згинілих зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема LM2904 73K D8JTG4 (Подвійний операційний підсилювач 26 В, 700 кГц) 	США (Texas Instruments)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Мікросхема C8051F220 HCL0FH 1736 (25 MIPS, 8 kB Flash, 8-Bit AD C, 48-Pin Mixed-Signal MCU. Аналогова периферія 8-розрядний АЦП. Напруга живлення: від 2,7 до 3,6 В. Діапазон температур: від -40 до +85 °C) 	США (Silicon Laboratories)		Замаскована на Мікросхе ма Маркування рф: 826-02 4792-01 580979 

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, одне вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Покеродно визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про об'єктивні захоплення (отримання), знищення зразку ОБТ	Примітки
		Радіоелемент 12,288M CM MP2653 (кварцовий резонатор частоти 12,8МГц) 	Китай (Huaban)		Досліджено ЦНД ОБТ ЗСУ
		Мікросхема 74CH 2951 ACME (Стабілізатор напруги LP2950/LP2951. Вихідний струм 100 мА. Є версії на 5 В, 3 В і 3,3 В) 	США (National Semiconductor)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Радіоелемент 12.800 JA50 8G (кварцовий резонатор на частоту 12,8 МГц) 	Китай (Huaban)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
5.2.	 Електронна плата №2	Мікросхема OP292G #1721 2282 (операційний підсилювач подвійний або четверний. Живлення: від 4,5 В до 33 В. Смуга пропускання з високим коефіцієнтом посилення: 4 МГц) 	США (Analog Devices)		

№ з/п	Найменування та тип ОВСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Посередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) знищення зразку ОВТ	Примітка
		Мікросхема TC620CV OA_1651 K2S (Датчик температури з подвійною точкою спрацьовування у діапазоні - 40°C до +125°C) 	США (Microchip Technology)		Досліджено ЦНДІ ОВТ ЗСУ
		Мікросхема ST e3 6 54008 *Y 8L3 (ВЧ транзистор, працює при напрузі 7 В та частоті до 1 ГГц. Потужність 8 Вт із посиленням 11,5 дБ при 500 МГц/7,5 В) 	Швейцарія (STMicro electronics)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема OP292G #1721 2282 (Операційний підсилювач подвійний або четверний. Живлення: від 4,5 В до 33 В. Смуга пропускання з високим коефіцієнтом посилення: 4 МГц) 	США (Analog Devices)		Досліджено ІНДІ ОБТ ЗСУ
		MCL H 1J8 ADC-26-52 (Спрямований відгалужувач у смузі частот від 10МГц до 500МГц, температурний діапазон роботи: від -40°C до 85°C) 	США (Mini-Circuits (Scientific Components Corp))		

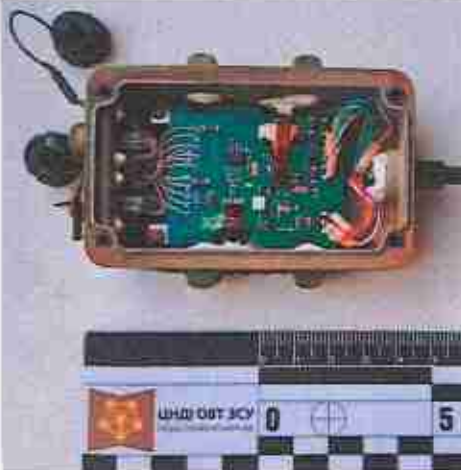
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС).	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
5.3.	 Електронна плата №3	Мікросхема DSP TMS 160 320VC5416PGE CD-69C05GW G4 (цифровий сигнальний процесор з фіксованою точкою) 	США (Texas Instruments)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Мікросхема 320AIC151 88T CKYJ (Малопотужний голосового діапазону CODEC 16-bit) 	США (Texas Instruments)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, апаратури (складової частини), де виявлено комплектування виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема C8051F023 H0008 1716 (Мікроконтролер, 64k Bytes FLASH, • програмований коефіцієнт посилення підсилювача: 16, 8, 4, 2, 1, 0,5 працює в діапазоні температур: 40°C to +85°C) 	США (Silicon Laboratories)		Досліджено ЦНД ОБТ ЗСУ Замаскована Маркування рф: 825-02 04789-01 580947 
		Мікросхема adesto1540 45DB041D SU (флеш-пам'ять із послідовним інтерфейсом, живлення 2,5 В-3,6 В, 128-байтний реєстр безпеки, мінімум 100 000 циклів програмування/стирання на сторінку, робоча температура: -40 до +85 °C) 	США (Adesto Technologies)		Замаскована Маркування рф: 824 580901 

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів ШАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема VISHAY T05232 143472 (схема сполучення електричних імпульсів з інфрачервоними імпульсами) 	США (Vishay Intertechnology)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Мікросхема CY22393FXI 1837 C 05 634333 OC (генератор тактових сигналів із трьома системами фазового автопідстроювання частоти) 	США (Cypress Semiconductor)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/опищення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема LM2904 63K ADN2G4 (двоканальний операційний підсилювач) 	США (Texas Instruments)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Мікросхема DS3231SN 1832A4 316AC (точний годинник реального часу із вбудованим кристалічним генератором) 	США (Maxim integrated)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема MAX3221 EUE +601 (Прийомопередавач RS-232 з автоматичним відключенням) 	США (Maxim integrated)		Досліджено ЦНД ОБТ ЗСУ
		Мікросхема 14093BG AK05E44 (Тригер Шмітта, діапазон напруги живлення від 3 В до 18 В постійного струму, Діапазон температур навколишнього середовища – 55 до +125 °C) 	США (ON Semiconductor Corporation)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема NXP TDA8541 E4-05 N6510 (Підсилювач аудіо) 	Нідерланди (NXP Semiconductors)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
5.4.	 Електронна плата №4 (маніпулятор)	Мікросхема (TS9221) 9221 GZ607 (подвійний операційний підсилювач, температурний діапазон -40, +125 °C) 	Швейцарія (STMicroelectronics)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (експлоативної частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
6.	БПЛА: Muglin-5 Pro Польотний контролер HEX Pixhawk 2.1 CUBE ORANGE+  це версія Pixhawk 2.1 CUBE з вмонтованим приймачем ADS-B для апаратів на базі Ardupilot. Приймач ADS-B 1090МГц від uAvionix інтегрований в нову плату завдяки чому CUBE ORANGE+ отримує інформацію про місцезнаходження від сусідніх літаків (планерів, вертольотів і тп.), усі деталі можливо побачити в Mission Planner включно положення, висоту, швидкість, ідентифікатор і тп. CUBE ORANGE+ працює лише з прошивками Ardupilot (ChibiOS) і потребує мінімальну версію 4.0	Технічні характеристики Процесор - STM32H757 Приймач ADS-B - 1090МГц Датчики – три 3-х осьових гіроскопа, три 3-х осьових акселерометра, три 3-х осьових магнітометра, два барометра З'єднання з ПК - microUSB	Китай/Тайвань (HEX)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ

№ з/п	Найменування та тип ОВСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОВТ	Примітка
		Мікроконтролер STM32 F100CBT6Q48  Технічні характеристики Ядро: 32-розрядний процесор Максимальна частота 24 МГц Пам'ять: від 16 Кбайт до 128 Кбайт флеш-пам'яті та від 4 Кбайт до 8 Кбайт SRAM	Швейцарія (STMicro Electronics)		Досліджено ЦНДІ ОВТ ЗСУ
		STM32H757A1 Подвійний 32-розрядний мікроконтролер Arm Cortex-M7 до 480МГц, 2 МБ, Flash, 1МБ RAM, 46 ком. і аналогові інтерфейси, SMPS, DSI, крипто. 	Швейцарія (STMicro Electronics)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо встановлена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/зніплення зразку ОБТ	Примітка
		Карта пам'яті SanDisk EDGE 16Гбт 	США (SanDisk)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Electronics A765 алюмінієвий конденсатор  Технічні характеристики: діапазон ємності від 47 мкФ до 2700мкФ допуск $\pm 20\%$ ємності Максимальна напруга 25В	США (KEMET Electronics)		
		Датчик тиску рівня плати DLVR-L-10D-E1BD-1P13N  Технічні характеристики: Тиск: 0,36 PSI Еталонний тиск: Диференціал Тип електронного виходу I2C Технологія зондування: MEMS	США (All Sensors)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплексувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/зніщення зразку ОБТ	Примітка
		Мікропротокольний модуль протоколів SoC EFR32FG13P321  Технічні характеристики: - 32-розрядне ядро ARM Cortex з максимальною робочою частотою 40 МГц; - 512 Кбайт флеш-пам'яті та 64 Кбайт оперативної; - Сумісність з контактами для сімейства EFR32FG; - 12-канальна периферична рефлекторна система забезпечення автономної взаємодії MCU периферійних пристроїв; - Автономний апаратний криптоприскорювач, генератор випадкових чисел	США (Silicon Laboratories)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Посередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Низьковольтний кремнієвий радіочастотний підсилювач потужності (РА) MAX2235  призначений для використання в діапазоні частот 900МГц. Працює безпосередньо від одного джерела живлення +2,7 В до +5,5 В, забезпечує вихідну потужність +30 дБм від джерела живлення +2,7 В.	США (Maxim Integrated)		Досліджено ЦНД ОБТ ЗСУ
		Електричний пристрій керування (перемикач) SKY 13348-374LF 	США (Skyworks Solutions)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСГ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплексувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Посередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) знішення зразку ОБТ	Примітка
		TXS0108E 8-розрядний двонаправлений перетворювач напруги для додатків з відкритим стоком і Push-Pull 	США (Texas Instruments)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Кристалічний блок NX2016SA для ОА/АВ бездротового зв'язку малого радіусу  Технічні характеристики Номинальна частота від 20 до 80МГц Діапазон робочих температур від -10 до +75 С° Діапазон температур зберігання від -40 до +85 С°	Японія (Nihon Dempa Kogyo)		

№ з/п	Найменування та тип ОВСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення втраченого ОВТ	Примітка
		FM25V02-G 256Kb F-RAM пам'ять  технічні характеристики 256 Кбіт сегнетоелектрична пам'ять (F-RAM) Частота до 40 МГц Промислова температура від -40 С° до +85 С°	США (Cypress Semiconductor)		Досліджено ЦНДІ ОВТ ЗСУ
		ICM-20649 6-осьовий MEMS-пристрій відстеження руху широкого діапазону 	Японія (TDK)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) збиття зразку ОБТ	Примітки
		TXB0108RGYR  8-бітний двонаправлений транслятор рівня напруги з автоматичним значенням напрямку та захистом OT ECP 15kB	США (Texas Instruments)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		ICM-20948 QFN-24  9-осьовий пристрій, підходить для смартфонів, планшетів, переносних датчиків. Поеднує в собі 3-осьовий гіроскоп, 3-осьовий компас і цифровий процесор руху	Японія (TDK)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Датчик барометричного тиску з нержавіючої сталі MS5611-01BA03LGA  Технічні характеристики Модуль високої роздільної здатності, 10см Швидке перетворення до 1 мс Низька потужність 1мкА Промислова температура від -40 C° до +85 C°	Швейцарія (TE Connectivity)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		TDK InvenSense ICM-42688-P 6-осьовий IMU з відстеженням руху  забезпечує ультразвукове виявлення перешкод незалежно від кольору об'єкта, матеріалів і умов навколишнього освітлення. Ці датчики забезпечують зондування ближнього діапазону.	Японія (TDK)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектуючого виробу, третіх країн або радіосекторних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
7.	Безпілотний літальний апарат тактичного рівня "Елерон-3СВ" 	Мікропроцесор XILINX Virtex-5 	США (XILINX)	Зразок був переданий до військової частини А4629 представниками управління розвідки оперативного командування "Північ" 27.01.2023	Досліджено в/ч А4629
		Мікроконтролер ATMEGA 2560 	США (Atmel)		
		Flash пам'ять SPANSION 	США (Spansion)		
		SDRAM пам'ять H5SS2622JFR-60M 	Південна Корея (Hynix)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання); знищення зразку ОБТ	Примітка
		Транзистор P725D 	Німеччина (Infineon Technologies AG)		Досліджено в/ч А4629
		Підсилювач SZA2044Z 700МГц-2,7ГГц 5В 1Вт 	США (Qorvo)		
		Мікроконтролер C8051F121 	США (Silicon Laboratories)		
		Модуль живлення LMZ14203 	США (National Semiconductor)		

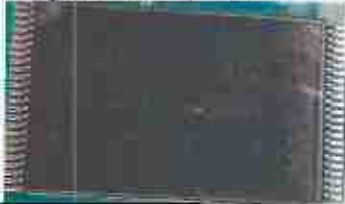
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) знищення зразку ОБТ	Примітка
		Передавач ADM3222 	США (Analog Devices)		Досліджено в/ч А4629
		Датчик тиску MPXAZ6115A SPDT 0 МГц до 2,5 ГГц 36 дБ 	Нідерланди (NXP Semiconductors)		
		Підсилювач RF2173 	США (Qorvo)		
		Операційний відео підсилювач ADA4853-3YRUZ 	США (Analog Devices)		

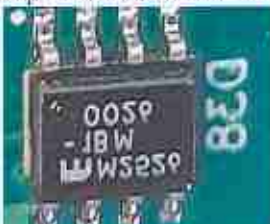
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо встановлена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/зніщення зразку ОБТ	Примітки
		Оперативна пам'ять CY62148EV30 	Німеччина (Infineon Technologies AG)		Досліджено в/ч А4629
		Контролер AGL125 	США (Actel)		
		Процесор STM32F103ZEH6 	Швейцарія (STMicro Electronics)		
		Перетворювач напруги TPS84250 	США (Texas Instruments)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) зразку ОБТ	Примітка
		Транзистор IRF7342 	Німеччина (Infineon Technologies AG)		Досліджено в/ч А4629
		Мікроконтролер STM32F103CBUB CH21693 	Швейцарія (STMicro Electronics)		
		Перетворювач напруги DC/DC MAXIM 2763E T1708 	США (Maxim Integrated)		
		Контролер STM32F415 	Швейцарія (STMicro Electronics)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) знищення зразку ОБТ	Примітка
		Передавач ADM3488 	США (Analog Devices)		Досліджено в/ч А4629
		Флеш-пам'ять AT45DB641E 	Японія (Renasas)		
		Конденсатор Yageo 	Тайвань (Yageo)		
		Датчик тиску MPXV5010DP 	Нідерланди (NXP Semiconductors)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компаній виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Передавач VP231 	США (Texas Instruments)		Досліджено в/ч А4629
8.	Вседобовий носимий прилад розвідки ВНПР ІПН142 	Мікросхема ATMEGA1280V  Мікросхема MAX II  Енергонезалежне джерело живлення з кристалом мікропотужної пам'яті M4T32-BR12SH6 	США (Atmel) США (Altera Corporation) Швейцарія (STMicro Electronics)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, одиниць вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема EP4CGX150CF23I7N 	США (Altera Corporation)		Досліджено в/ч А4629
		Мікросхема ADV7123 	США (Analog Devices)		
		Мікросхема CBTLV16210 	США (Integrated Device Technology)		
		Мікросхема 29F16G08FAA 	США (Micron Technology)		

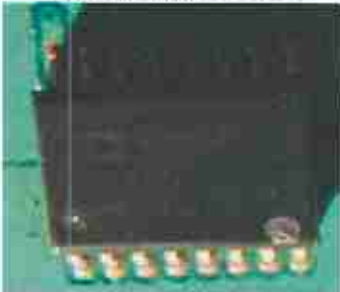
№ з/п	Найменування та тип ОЗСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОВТ	Примітка
		Мікросхема TMS320DM368ZCED 	США (Texas Instruments)		Досліджено в/ч А4629
		Мікросхема M2526-IBM 	США (Microchip Technology)		
		Мікросхема ATMEGA644P 	США (Microchip Technology)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
9.	Виріб 9-С-7760 аеробалістична авіаційна керована ракета Х-47, комплексу Кінжал Серійний № 776061005  Виробник (розробник) зразка, кооперація; Виріб 9-С-7760 аеробалістичної АКР Х-47 розроблена ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» («ОАК»); АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» (м. Корольов, Московська обл.). Можливі співвиконавці по основним складовим: Загальні системи: Смоленский авиазавод, г. Смоленск, РФ; Бортова обчислювальна система:	Транзистор BA996A1 	Японія (ROHM)	Відповідно до доручень Першого заступника Міністра оборони України №11693/з від 28.04.2023, Заступника начальника Генерального штабу №28590/С від 28.04.2023 та звернення першого заступника голови Львівської обласної військової адміністрації №5/5-3668/0/2-23/1-27.1.2 від 26.04.2023 робоча група фахівців Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України у період з 27.04.2023 по 29.04.2023 провела ідентифікацію, аналіз стану, знешкодження з подальшим вилученням вибухонебезпечного предмету. Місце проведення робіт: Добровірська теплова електрична станція, Червоноградського р-ну, Львівської області.	Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Датчик температури MS03951 	Іспанія (SICSSA)		
		Мікрохема SGM1608W1M 	США (Nelson)		
		16 розрядний буфер та лінійний драйвер з 3 виходами LVT162244A 	США (Texas Instrument)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплексуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Повернено визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
	"Московское опытно-конструкторское бюро "МАРС", г. Москва, РФ; АО "Научно-производственный комплекс" ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко", г. Чебоксары, РФ; Бортова навігаційна система: АО "Раменский приборостроительный завод", РФ; КБ "Навигационных систем "Навис", г. Москва, РФ; ООО "Элементавиа", г. Москва, РФ Система вимірювання повітряних сигналів СВПС; ОАО «Аэроприбор-Восход», г. Москва, РФ. Радіообладнання: АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь", г. Каменск-Уральский, РФ); АО КБ Луч, г. Рибінськ, РФ; Рыбинский завод приборостроения, ВАТ «РЗП», г. Рибінськ, РФ) Оптическая корреляционная система наведения ФГУП «ЦНДІ автоматики та гидравлики», г. Москва, РФ	Пам'ять 256 Мб (32 Мб x 8) MX29GL256FHT21-90Q 	Тайвань (Macronix)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		8-ми канална шина трансівер с 3 выходами LS245 	США (Texas Instrument)		
		Діод генерації імпульсів 841e3, 805e3  Трансівер MAX211EEAT 	США (Vishay Intertechnology) США (Maxim Integrated)		

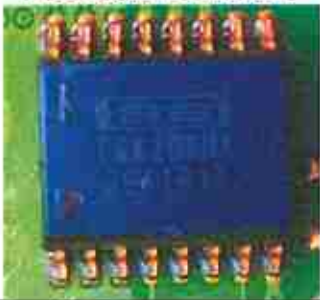
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (експлоативної частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/зніщення зразку ОБТ	Примітка
		Діодна пара B20100CT 	США (Integrated Rectifier)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Двох функціональний запобіжниковий резистор F5210S 	США (Integrated Rectifier)		
		Транзистор BCP53 	Швейцарія (STMicroelectronics)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектуючого виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		12-бітний послідовний DACPORT AD7243BR 	США (Analog Devices)		Досліджено ЦНД ОБТ ЗСУ
		12-разрядний аналогово-цифровий перетворювач AD7450BRZ 	США (Analog Devices)		
		Інтегральна схема 8138A 	США (Analog Devices)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо встановлена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення/тратку ОБТ	Примітки
		3-канальний цифровий ізолятор ADUM1301 CRWZ 	США (Analog Devices)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		16-бітний трансівер ABT16245A 	США (Texas Instrument)		
		Товстоплівкові резистори MP915-10.0-1% 1829 	США (CADDOCK)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСГ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Посередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Опис функціонального призначення не знайдено 1BAYSKK G4 65C23243 	США (Texas Instrument)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		64 Мбайт флеш-пам'ять 2RC22 D9MHP 	США (Micron)		
		Система на кристалі, побудована на x86-сумісній ядрі Vortex86DX 	Тайвань (DM&P Electronics)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Слабозумлячий лінійний регулятор 1,5 А 337e3 963A33 	США (Linear Technology)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Флеш-пам'ять об'ємом 64Мбіт 25Q64FV51G 	Тайвань (Winbond)		
		Програмована вузькоспеціалізована ASIC-мікросхема XC2S50-TQG144AMS 	США (Xilinx)		

№ п/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Високошвидкісний інструментальний підсилювач з програмованим підсиленням PGA206UA 39AIR1T 	США (Burr Brown)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Широкосмуговий завадопридушуючий фільтр BNX022 	Японія (Murata)		
		4/8-канальний мультиплексор ADG509FB #1302 2533513 	США (Analog Devices)		

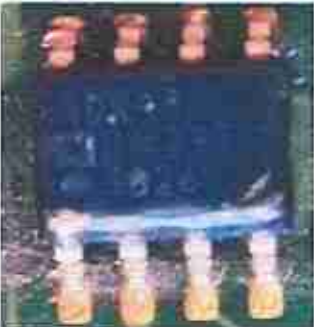
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплексуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо вказана країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/типівний зразок ОБТ	Примітка
		Опис функціонального призначення не знайдено HT573 38K G4 D2XK 	США (Texas Instrument)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Опис функціонального призначення не знайдено 78336 596.VS 	США (Xilinx)		
		Трьохканальний цифровий ізолятор ADUM1300 BRWZ #1333 2677991.1* 	США (Analog Devices)		

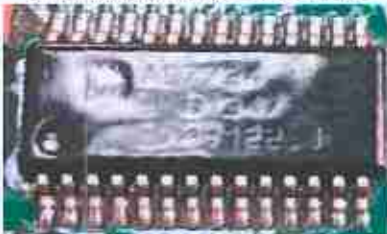
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Трьохканальний цифровий ізолятор ADUM1300 C #1344 2736425.1* 	США (Analog Devices)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Опис функціонального призначення не знайдено ADG 1409Y #326 	США (Analog Devices)		
		Опис функціонального призначення не знайдено HT142AK G4 CQVP 	США (Texas Instrument)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) зніплення зразку ОБТ	Примітка
		Високоточне джерело опорної напруги VRE3025J 	США (Apex Microtechnology)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Програмована вентиляна матриця APA150 FG144 	США (Actel)		
		SRAM – паралельна інтегральна схема асинхронної пам'яті на 4 Мбіт CY7C1041DV33-10BVI 	США (Cypress Semiconductor)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, апарату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Високошвидкісний CVOS 20-ти бітний шинний комутатор з проточним розведенням QS32X861Q1G 	США (Integrated Device Technology (IDT),		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Шестигранний інвертор з тригерним входом Шмітта PCUAB 74AC14 	США (Fairchild Semiconductor)		
		Інтегральна мікросхема з вбудованим складним програмованим логічним пристроєм EPM7256SR1208-10N 	США (Altera/Intel)		

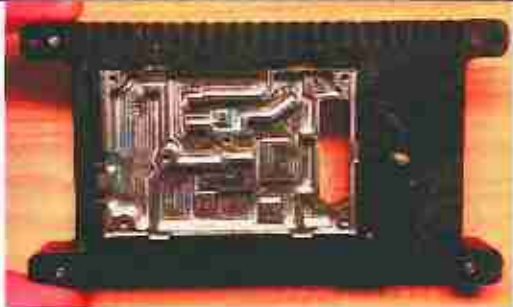
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Подвійний прийомопередавач низької потужності HI-1567CDI 	США (Holt Integrated Circuits)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Реле 4A 1/20HP125 	Японія, виготовлено в Німеччині (Matsushita Panasonic)		
		Перетворювач DC/DC TSM0505S 	Швейцарія (Traco Power)		
		Перетворювач DC/DC TEN 20-2411 	Швейцарія (Traco Power)		

№ п/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектувачі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Біполярний транзистор 149 P126 	Японія (Toshiba)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		4/8-канальний високопродуктивний аналоговий мультиплексор ADG409BR #1346 	США (Analog Devices)		
		Опис функціонального призначення не знайдено ADR431 B#233 3826 	США (Analog Devices)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (огримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Опис функціонального призначення не знайдено ADR01B #599 5958 	США (Analog Devices)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Опис функціонального призначення не знайдено AMPO3G #1345 P44242 	США (Analog Devices)		
		24-бітний високоточний АЦП з високою пропускнуою здатністю AD7734 B#1347 2749122.1 	США (Analog Devices)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Опис функціонального призначення не знайдено ADT 7310 TRZ 	США (Analog Devices)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
10.1.	Блок оброблення відеопотоку БІЦІА "ZALA Ланцет-3" 	Чіп інтерфейсу Трансивер Gigabit Ethernet із підтримкою RGMII KSZ 9031RNXIA 2113A2T G000002113EQA Ethernet TXRX Single Chip 1Port 1.8V/2.5V/3.3V 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 48Pin QFN EP 4/4 Transceiver Full Ethernet 48-QFN (7x7)  Робоча температура -40 °C ~ +85 °C	США (Microchip Technology)	Зразок надано розвідувальними органами в березні 2023 року.	

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (окладової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
	 Зворотній бік блоку оброблення відео	Відео декодер ADV 7180W #2129 619437 1ADC 10Bit Automotive 40Pin LFCSP EP T/R  Робоча температура -40 °C ~ +125 °C	США (Analog Devices)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Тонкоплівковий резистор YJ612 TI 84K CL7  Робоча температура -55 °C ~ +125 °C	США (AVX Corporation)		

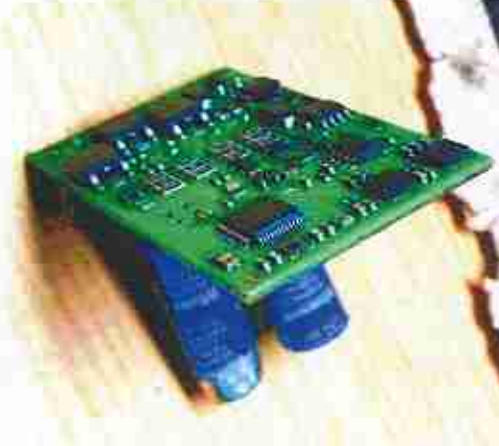
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоселекtronних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/зніплення зразку ОБТ	Примітка
		Малопотужний стереоаудиокодек ADAU 1961WB #2225 5847236 PHIL Стереозапис 48 кГц, відтворення при 35 мВт від аналогового джерела живлення 3,3 В. Стереоаудіо АЦП і ЦАП підтримують частоту дискретизації від 8 кГц до 96 кГц, а також цифровий регулятор гучності.  Робоча температура $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$	США (Analog Devices)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ

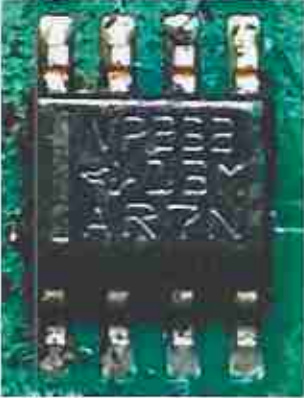
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/зміцнення трезку ОБТ	Примітка
		Мікропроцесор XILINX ZYNQ XC7Z020 CLG484ABX22 MPU Zynq-7000 Thumb-2 32Bit 733MHz 1.2V/3.3V 484Pin CSBGA  Робоча температура 0 °C ~ +100 °C	Тайвань (Xilinx)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Чіп пам'яті серії D9 9LK17 D9P3K DRAM Chip DDR2 SDRAM 512Mbit 32Mx16 1.8V Automotive 60Pin FBGA  Робоча температура -40 °C ~ +105 °C	США (Micron Intel)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/іншіснення тратку ОБТ	Примітка
		Високопродуктивний RF Agile трансивер AD 9364BBCZ #2116 5311566 Радіочастотний трансивер 1x1 з інтегрованими 12-бітними ЦАП/АЦП  Робоча температура -40 °C ~ +85 °C	США (Analog Devices)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Чіп 1755 ADJ #215 72108  Робоча температура 0 °C ~ -70 °C	США (Analog Devices)		

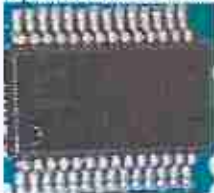
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітка
		Двоканальний контролер TPS 34261 TI2241 AN43  Робоча температура -40 °C ~ +125 °C	США (Texas Instruments)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
10.2.	Електропривод з блоком керування задніх крил БПЛА "ZALA Ланцет-3" 	Мікроконтролер ATMEGA48V 10U-PH 35SE5G 2110SH5 Високопродуктивний, малопотужний 8-розрядний мікроконтролер AVR на основі RISC поєднує 4 кБ флеш-пам'яті ISP, 512 байт SRAM, 256 байт EEPROM, 8-канальний/10-бітний АЦП (TQFP і QFN/MLF)  Робоча температура -40 °C ~ +85 °C	США (Atmel)		

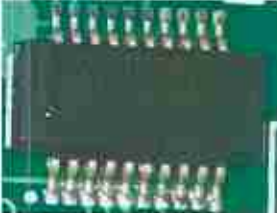
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення трапсу ОБТ	Примітка
		Транзистор ME4542GA36-1 N та P каналний 30B (D-S) Mosfet  Робоча температура -40 °C ~ +105 °C	Тайвань (VBsemi Electronics)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
10.3.	Плата (блок управління живленням) БПЛА "ZALA Ланцет-3" 	Мікроконтролер ATME ~ 0A U-H 8A 35 214  Робоча температура -40°C ~ +85°C	США (Atmel)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис пульта, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення тратку ОБТ	Примітки
10.4.	Гіроскоп БПЛА "ZALA Ланцет-3"  (зворотня сторона)  	Транзистор LR7843 P141D SM 19 Trans MOSFET N-CH 30V 161A 3Pin(2+Tab) DPAK T/R N-Channel 30V 161A (Tc) 140W (Tc) Surface Mount D- Pak  Робоча температура -55°C ~ +175°C	США (International Rectifier)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Мікроконтролер STM32 F103G8T6 TWN AA1144 STM32F103 Cortex, Flash 64KB, RAM 20KB, ADC 12Bit x 10, Timer 16Bit x 4, 24Bit down Counter, SPI x 2, I2C x 2, USART x 5, USB,CAN,RTC, WDG x 2, LQFP48 Package  Робоча температура -40°C ~ +85°C	Швейцарія (STMicroelectronics)		

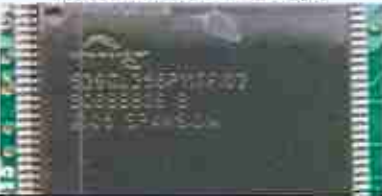
№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Поверхньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) / знищення зразку ОБТ	Примітка
		Акселерометр XL 326B #2203 2283F 3-вісний 16g 2.5V/3.3V 51mV/g to 63mV/g 16Pin LFCSP EP Tray  Робоча температура -55°C ~ +125°C	США (Analog Devices)		Досліджено ЦНДІ ОБТ ЗСУ
		Мережевий контролер VP232 28M AR7N (джерело живлення 3.3 В)  Робоча температура -55°C ~ +125°C	США (Texas Instruments)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/зніснення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема XCR3128XL 	США (Xilinx)		Досліджено в/ч А4629
		Мікросхема MAX3223-EP 	США (Maxim Integrated)		
		Карта пам'яті SanDisk CompactFlash Ultra 8GB 	США (SanDisk)		
		Мікросхема OXuPCI954-LQAG MY17N-001 	США (Oxford Semiconductor)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення гразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема DCR010503 	США (Texas Instruments)		Досліджено в/ч А4629
		Мікросхема ADUM1301 	США (Analog Devices)		
		Мікросхема XCR3084XL 	США (Xilinx)		
		Мікросхема ADM211 	США (Analog Devices)		

№ з/п	Найменування та тип ОВСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання) / знищення зразку ОВТ	Примітка
		Мікросхема 74ABT1250 	Нідерланди/ Китай (Nexperia)		Досліджено в/ч А4629
		Твердотільний накопичувач SSD 64ГБ TS64GPSD520 	Тайвань (Transcend)		
		Мікросхема XC2V250 (GF256AFT131) 	США (Xilinx)		
		Мікросхема MAX1714A 	США (Analog Devices)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/зніщення зразку ОБТ	Примітка
		Мікросхема DS90CF384MTD 	США (Texas Instruments)		Досліджено в/ч А4629
		Мікросхема STDP8028 	Швейцарія (STMicroelectronics)		
		Мікросхема W9751G6KB-25 	Тайвань (Winbond)		
		Мікросхема CY7C1069DV33 	США (Cypress Semiconductor)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплексуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та СС)	Найменування комплексувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення тратку ОБТ	Примітки
		Мікросхема S29GL256P11TF102 	США (Spansion Inc.)		Досліджено в/ч А4629
		Мікросхема LVTH16245A 	США (Texas Instruments)		
		Мікросхема MAX211EEA1 	США (Texas Instruments)		
		Мікросхема EPF10K100ARC240-2N 	США (Altera/Intel)		

№ з/п	Найменування та тип ОБСТ, опис вузла, агрегату (складової частини), де виявлено комплектуючі виробництва третіх країн (членів НАТО та ЄС)	Найменування комплектувального виробу третіх країн або радіоелектронних компонентів	Попередньо визначена країна виробник (найменування компанії виробника)	Відомості про обставини захоплення (отримання)/знищення зразку ОБТ	Примітки
		Мікросхема ALS760 	США (Texas Instruments)		Досліджено в/ч А4629
		Мікросхема EPC2TC32N 	США (Altera/Intel)		

